

镓靶材Ga氧化镓靶材Ga₂O₃磁控溅射靶材

产品名称	镓靶材Ga氧化镓靶材Ga ₂ O ₃ 磁控溅射靶材
公司名称	北京晶迈中科材料技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:晶迈中科 型号:根据客户要求定制 产地:北京
公司地址	北京市通州区张家湾镇北大化村东(北京五木服装有限责任公司)2幢二层B2256(注册地址)
联系电话	010-86208200 13301329625

产品详情

科研实验专用镓靶材Ga氧化镓靶材Ga₂O₃磁控溅射靶材电子束镀膜蒸发料

产品介绍

氧化镓(Ga₂O₃)别名是三氧化二镓,是一种宽禁带半导体,E_g=4.9eV;不溶于水,微溶于热酸或碱溶液,易溶于碱金属氢氧化物和稀无机酸;有α,β两种变体,α型为白色菱形六面体,熔点:1900(在600℃时转化为β型)。用作高纯分析试剂、用于电子工业半导体材料制备。它是一种透明的氧化物半导体材料,在光电子器件方面有广阔的应用前景,被用作于Ga基半导体材料的绝缘层,以及紫外线滤光片。它还可以用作O₂化学探测器。

产品参数

中文名 氧化镓 分子式 Ga₂O₃

分子量 187.44 熔点 1740

密度 5.88g/ml 纯度 99.99%

镓(Ga)是灰蓝色或银白色的金属,熔点很低,沸点很高,在大约1500℃时有很低的蒸汽压;纯液态镓有显著的过冷的趋势,在空气中很稳定。在29.76℃时变为银白色液体。微溶于汞,形成镓汞齐。镓能浸润玻璃,故不宜使用玻璃容器存放。常温时镓在干燥空气中稳定,很容易水解,镓与碱反应放出氢气,生成镓酸盐;能被冷浓盐酸浸蚀,对热硝酸显钝性,高温时能与多数非金属反应;制造半导体氮化镓、砷化镓、磷化镓、锗半导体掺杂元;纯镓及低熔合金可作核反应的热交换介质。

中文名 镓 元素符号 Ga 原子量 69.723

熔点 29.8 密度 5.91g/cm 沸点 2403

支持靶材定制，请提供靶材产品的元素、比例（重量比或原子比）、规格，我们会尽快为您报价！！

服务项目：靶材成份比例、规格、纯度均可按需定制。科研单位货到付款，质量保证，售后无忧！

产品附件：发货时产品附带装箱单/质检单/产品为真空包装

交货周期：现货当天发，常规期货4周内

适用仪器：多种型号磁控溅射、热蒸发、电子束蒸发设备

质量控制：严格控制生产工艺，采用辉光放电质谱法GDMS或ICP光谱法等多种检测手段，分析杂质元素含量保证材料的高纯度与细小晶粒度；可提供质检报告。

加工流程：熔炼 提纯 锻造 机加工 检测 包装出库